The magnetic relaxation of MgB₂ powder

Jeong Hun Yang, Jong Su You, Soo Kyung Lee, and Kyu Jeong Song*

Div. of Science Education and Institute of Sci. Education, Jeonbuk National University, Jeonju, 54896 Korea

(Received 28 August 2023; revised or reviewed 28 September 2023; accepted 29 September 2023)

Abstract

Magnetic relaxation properties of pure MgB₂ powder samples and diluted water-treated MgB₂ powder samples were investigated. The magnetic field *H*-dependence, m(H), and the time *t*-dependence, m(t), of the magnetic moment *m* were measured and analyzed using the PPMS-VSM magnetometer equipment, respectively. The m(t) reduction rates of pure MgB₂ powder samples and diluted water-treated MgB₂ powder samples decreased to about $0.7 \sim 1.8\%$ and $0.6 \sim 1.0\%$ for about 7200 s, respectively, at temperature T = 15 K. The magnetic relaxation properties of the two types of MgB₂ powders were analyzed by calculating the magnetic relaxation rate $S = -d\ln(M_{irr})/d\ln(t)$ values according to Anderson-Kim theory. The magnetic relaxation ratio S values of the two types of MgB₂ powder samples were almost similar. As a result of the quantum creep effect, the constant magnetic relaxation rate S characteristic was confirmed at a temperature range of T = 10 K or less.

Keywords: MgB2 powder, magnetic moment, magnetic relaxation rate, flux creep, quantum creep effect

1.서 론

2001년도 발견된 MgB2 초전도체는 현재까지 다양한 초전 도 특성들을 나타내고 있다[1-3]. MgB₂는 금속성 초전도체로 서 높은 임계전이온도 T_c = ~ 39 K 특성, 두-밴드 (2D-σ 및 3D-π) 초전도 특성, 입계 경계면을 가로지르는 입계들 사이의 강한연결(strong-link) 전류흐름 특성, 및 높은 비등방적 초전 도 특성 등을 나타내고 있다[4-7]. 특히, 물질 내에 인위적인 자 속고정 결함들(artificial flux pinning defects)을 도입으로 MgB2의 자기적 특성들이 현저하게 향상하는 특성과 물질 내에 비자성 불순물들(nonmagnetic impurities) 도핑(doping)으로 증가되는 무질서도(disorder)에 의한 MgB₂의 상부임계자기장 (upper critical field) H_{c2} 값이 획기적으로 향상하는 특성들을 보여주고 있다[8-11]. 이와 같은 기본적인 초전도 특성들의 향 상으로 MgB2 초전도체는 의료용 MRI 마그넷 개발 등 산업적 응용 가능성이 커지고 있으나, H=2T 이상의 높은 자기장과 T = 20 K 이상의 높은 온도에서 MgB₂의 전류흐름 성능 등이 급격히 저하되는 단점으로 인하여 MgB2 상용화가 활발하게 이 루어지지 않고 있는 실정이다. 따라서 MgB2 초전도체의 상용 화를 위해서는 지속적으로 기본적인 MgB2 초전도 물리량들의 특성향상 연구와 더불어 MgB2 초전도체의 세밀한 자기적 특성 연구들이 병행되어야 한다. 일반적으로 고온초전도체들은 입 계 사이의 약한 결합(weak-coupling)과 거대한-자속-저속거 동(giant flux creep) 특성들을 가지고 있으나[12], 이와 반대로 MgB₂ 초전도체는 입계 사이의 강한 결합(strong-coupling)과 작은-자속-저속거동(small flux creep) 특성들을 가지고 있다 [6, 13-14]. 자속 고정 결함들을 도입한 고온초전도체들의 거 대한-자속-저속거동에 대한 자기완화(magnetic relaxation) 연구들이 많이 진행되어 있으나[12], MgB₂ 초전도체의 경우에 는 오직 MgB₂ 박막(thin film) 시료에 국한하여 자기완화 연구 가 일부 진행되었다[13-14]. 따라서 MgB₂ 초전도체의 전체적 인 자기적 특성들을 이해하기 위해서는 MgB₂ 분말(powder) 들에 대한 추가적인 자기완화 연구들이 필요하다.

본 논문은 순수한 MgB2 초전도 분말 시료와 증류수-에탄올 혼합물 처리된 MgB2 초전도 분말 시료들의 자기완화 연구들을 수행하였다. 물성특성측정시스템(physical property measurement system, PPMS) 마그네토미터(magnetometer) 장비를 이용하여 일정한 자기장 H와 온도 T에서 준비된 MgB2 분말 시료들의 자기모멘트의 시간의존성 m(t) 변화량을 측정하 여 분석하였다. 측정된 m(t) 값들을 이용하여 Anderson-Kim 이론[15]에 의한 자기완화비율(magnetic relaxation rate) S값 들을 구하였다. 순수한 MgB2 초전도 분말 시료와 증류수-에탄 올 혼합물 처리된 MgB2 초전도 분말 시료들의 자기완화비율 S 값들은 서로 큰 차이가 없었으며, MgB2 박막 시료의 자기완화비 율 S값들 분석결과[14]와 유사하게, T = 10 K 이하의 낮은 온도 영역에서 일정한 자기완화비율 S 값들의 특성을 보이는 양자-저속거동-효과(quantum creep effect)[16] 특성을 보였다.

2. 실험 과정

자기완화 연구를 위해 두 종류의 MgB₂ 분말 시료들을 준비 하였으며, 하나는 Alfar Aesar 회사에서 구입한 상용화된 순수 한 MgB₂ 분말(pure MgB₂ powder) 시료이고, 다른 하나는 증 류수-에탄을 혼합물 처리된 MgB₂ 초전도 분말(diluted water-treated MgB₂ powder) 시료이다. 이전 논문에서 기술 하였듯이 상용화된 MgB₂ 분말 시료는 XRD 분석에서 불순물 상(phase)이 거의 없는 순수한 MgB₂ 분말 시료이고, 증류수-

^{*} Corresponding author: songkj@jbnu.ac.kr

에탄올 혼합물 처리된 MgB₂ 초전도 분말 시료는 증류수 4 ml 와 에탄올 16 ml혼합물 안에 3일간 유지한 후 꺼내어 70 °C 온 열판위에서 습기를 완전히 제거하여 얻은 MgB₂ 초전도 분말 시료이다[17-18]. 실험에 사용한 순수한 MgB₂ 분말 시료의 질 량은 31.2 mg이고, 증류수-에탄올 혼합물 처리된 MgB₂ 초전 도 분말 시료의 질량은 26.1 mg이다.

미국 Quantum Design 회사의 물성특성측정시스템 PPMS-VSM 장치를 이용하여 T=5K 부터 T=45K 까지 온 도영역에서 준비된 두 종류 MgB2 분말들의 각 온도별 자기모 멘트 m의 자기장 H세기 의존성 m(H)을 측정하였다. 측정된 자기모멘트 m의 단위는 [emu = G· cm³]이고, 데이터 분석할 때 사용한 자기모멘트 m의 단위는 측정값을 시료의 질량으로 나눈 단위질량당 자기모멘트 m의 단위로서 [emu/g]이다. 한편, m(H) 측정에 사용된 PPMS-VSM 장치를 동일하게 이용하여 MgB₂ 분말들의 자기완화 측정들을 수행하였다. 이전 논문에서 기술하였듯이[14], 자기완화 측정 방법은 다음과 같이 순서대 로 기술할 수 있다. 첫 번째, 자기장을 인가할 때, 자기장이 증 가하는 영역에서는 목표 지정된 자기장 값보다 더 높은 자기장 에 도달하지 못하도록 하고, 자기장이 감소하는 영역에서는 목 표 지정된 자기장 값보다 더 낮은 자기장에 도달하지 못하도록 하는 No-overshoot 모드를 선택하여 사용하였다. 두 번째, 주 어진 온도 7에서 전체 자기 이력곡선(full magnetic hysteresis loop)을 zfc(zero field cooling) 조건에서 측정하였다. 세 번째, 위의 두 번째를 실행함으로써 시료 내에 자속을 완전히 통과시 킨 후, 자기장이 증가하는 영역에서 지정된 자기장 Hr세기를 인가하였다. 네 번째, 자기장이 증가하는 영역에서 인가한 지정 된 자기장 Hr세기를 일정하게 유지한 채로 자기모멘트 감소율 m(t) 값들을 측정하였다. 여기서 시간의 함수로서 m(t) 값들은 t~ 100 s 시간 간격으로 t~ 7200 s 까지 측정하였다. 다섯 번 째, 위의 네 번째를 수행한 후, 자기장 H=7T 까지 충분히 큰 자기장을 인가하였다. 그리고 자기장이 감소하는 영역에서 인 가한 지정된 자기장 Hr세기를 일정하게 유지한 채로 자기모멘 트 감소율 m(t) 값들을 위와 동일하게 측정하였다. 이와 같은 방법으로 지정된 온도들(T=5K~35K)에서와 지정된 자기 장 세기들(H_T = 1000 G ~ 10000 G)에서 반복적으로 자기모 멘트 감소율 m(t) 값들을 각각 측정하였다.

한편, 비가역 자기자화도(irreversible magnetization) $M_{irr}(H)$ 값들을 자기모멘트 m의 자기장 H세기 의존성 m(H)측정값들로부터 구하였다. 비가역 자기자화도 $M_{irr}(H)$ 는 $M_{irr}(H) = |M_{mea} - M_{avg}|$ 이고, $M_{avg} = [M(H_{dec}) - M(H_{inc})]/2$ 이며, $M(H_{inc})$ 와 $M(H_{dec})$ 는 M(t) 측정값으로부터 각각 자기장 이 증가하는 영역과 감소하는 영역에서 자기자화도 값들이다 [14]. Bean 임계상태 모델[19]을 이용하여 $J_c(H, T, t) \propto M_{irr}(H, T, t)$ 데이터들을 얻을 수 있고, 이로 부터 자기완화비 율(magnetic relaxation rate) $S = -dn(M_{irr})/dn(t)$ 을 구하여 분석하였다[15].

3. 결과 및 논의

순수한 MgB₂ 분말(pure MgB₂ powder) 시료와 증류수-에 탄올 혼합물 처리된 MgB₂ 분말(diluted water-treated MgB₂ powder) 시료들에 대해, 물성특성측정시스템인 PPMS-VSM 장비를 이용하여, *T* = 5 K부터 *T* = 45 K까지 온도영역에서

Fig. 1. The The magnetic moment *m* versus magnetic field *H* of the pure and the diluted water-treated MgB₂ powders, at T = 15 K.

자기모멘트 m의 자기장 H의존성인 m(H) 그래프들을 측정하 였다. 모든 m(H) 그래프들은 임계전이온도 T_c(~ 39 K) 이상 의 온도에서 측정한 백-그라운드 m(H) 그래프들을 이용하여 보정하였다. Fig. 1은 특정온도 T = 15 K에서 두 종류의 MgB₂ 초전도 분말 시료들에 대한 자기모멘트 m(unit: emu/g)과 자 기장 H의 의존성 관계인 m(H) 그래프들을 나타낸 것이다. Fig. 1에서 알 수 있듯이, 자기장 H의 전체 영역에서 순수한 MgB₂ 분말 시료의 자기모멘트 m 값들이 증류수-에탄올 혼합물 처리 된 MgB₂ 분말 시료의 자기모멘트 m 값들보다 상당히 큼을 알 수 있다. 일반적으로 에탄올로 처리된 MgB₂ 분말들의 초전도 성은 감소됨이 없이 일정하게 유지되지만, 희석된 물로 처리된 MgB₂ 분말들의 초전도성은 물의 희석 정도에 따라 급격하게 저하됨을 이전 논문에서 발표하였다[17-18]. Fig. 1의 증류수-에탄올 혼합물 처리된 MgB₂ 분말 시료는 증류수 4 ml와 에탄 올 16 ml혼합물로 처리하여 얻은 MgB₂ 초전도 분말 시료이다.

일반적으로 초전도 내에 자속(magnetic flux or vortex)들이 열에너지 등을 받으면, 기존 고정위치에서 다른 고정위치로 점 프하며 움직이는데, 이러한 움직임의 현상들을 "자속-저속거 동(magnetic flux creep)"이라 부른다[12]. 이와 같은 자속-저속거동, 즉 자기완화 효과로 해석하는 실험 결과의 하나는 시 간의 함수로서 자기모멘트 m(t) 값들이 천천히 변화하는 것이 다. 따라서 MgB₂ 박막 시료에 대한 자속완화 연구결과처럼 [14], 순수한 MgB₂ 분말과 증류수-에탄을 혼합물 처리된 MgB₂ 분말들의 자기완화 비율 S를 분석하고, 고유한 자속고정 효과 등을 조사하기 위해 특정한 자기장 및 특정한 온도에서 두 종류 MgB₂ 분말 시료들의 자기모멘트 m(t)의 시간의존성들을 측정하였다.

Fig. 2는 순수한 MgB₂ 분말 시료의 자기모멘트 *m*(*t*) 값에 대 한 시간의존성 그래프들을 보여주고 있다. Fig. 2(a)는 증가하 는 자기장 *H*_{inc} 영역에서 인가한 지정된 자기장 *H*_T세기를 1000 G로 일정하게 유지하고 지정된 온도들(*T* = 5 K ~ 35 K)에서 측정한 자기모멘트 *m*(*t*) 값에 대한 시간의존성 그래프들이며, Fig. 2(b)는 감소하는 자기장 *H*_{dec}영역에서 인가한 지정된 자기 장 *H*_T세기를 1000 G로 일정하게 유지하고 지정된 온도들(*T* = 5 K ~ 35 K)에서 측정한 자기모멘트 *m*(*t*) 값에 대한 시간의존 성 그래프들이다. 측정된 *m*(*t*) 데이터들은 약 100 s 간격으로 약 7200 s 까지 시간 *t*의 함수로서 측정한 것이다. 그리고 Fig. 2(a)와 (b)의 온도 *T* = 5 K 그래프들을 확대한 Fig. 2(c)와 (d)





Fig. 2. Magnetic moment *m* versus time *t* of pure MgB₂ powder for (a) the increasing field H_{inc} branch and (b) the decreasing field H_{dec} branch, at temperatures from 5 to 35 K with field of H = 1000 G. (c) and (d) show the magnified view of m(t) at T = 5 K from (a) and (b), respectively.

의 그래프들에서 알 수 있듯이, 온도 *T* = 5 K에서 약 7200 s 동안 자기모멘트 *m* 값들이 0.5~1.0% 정도 감소함을 알 수 있는데, 고온초전도체의 ~20% 감소비율에 비해 현저하게 낮으며, MgB₂ 박막시료 *c*-축 방향의 2~3% 감소비율보다 4배 정도 더 낮고, MgB₂ 박막시료 ab-평면의 0.2~0.3% 감소비율의 크기와 유사함을 알 수 있다[12, 14]. 그리고 온도 *T* = 15 K에서 약 7200 s 동안 순수한 MgB₂ 분말 시료의 자기모멘트 *m* 값들의 감소율은 0.7~1.8% 정도로서 *T* = 5 K의 감소율과 유사하였다.

한편, Fig. 3은 증류수-에탄올 혼합물 처리된 MgB2 분말 시 료의 자기모멘트 m(t) 값에 대한 시간의존성 그래프들을 보여 주고 있다. Fig. 3(a)는 증가하는 자기장 Hinc 영역과 감소하는 자기장 H_{dec} 영역에서 각각 인가한 지정된 자기장 H_T 세기를 1000 G로 일정하게 유지하고, 각각 지정된 온도들(T = 15 K, 25 K, 및 35 K)에서 약 100 s 간격으로 약 7200 s 까지 시간 t 의 함수로서 각각 측정한 자기모멘트 m(t) 값에 대한 시간의존 성 그래프들이다. 그리고 Fig. 3(a)의 온도 T = 15 K 그래프들 을 확대한 Fig. 3(b)와 (c)의 그래프들에서 알 수 있듯이, 온도 T = 15 K에서 약 7200 s 동안 자기모멘트 m 값들이 0.6~1.0% 정도 감소함을 알 수 있는데, 순수한 MgB2 분말 시료의 자기모 멘트 m 값들의 0.5~1.0% 감소비율 크기와 거의 일치함을 알 수 있다. 이와 같은 결과들을 통해 본 연구에서 사용된 두 종류 의 MgB2 분말들의 자속고정효과(flux pinning effect)는 MgB2 박막시료의 c-축 방향 경우보다 현저하게 강하며 ab-평면 경 우와 다소 비슷함을 예측할 수 있다. 또한, Fig. 4는 증가하는 자 기장 Hinc 영역과 감소하는 자기장 Hdec 영역에서 지정된 온도 T = 15 K를 일정하게 유지하고, 각각 지정된 자기장 세기들(Hr = 1000 G ~ 10000 G)에서 약 100 s 간격으로 약 7200 s 까지 시 간 t의 함수로서 각각 측정한 자기모멘트 m(t) 값에 대한 시간 의존성 그래프들이다.

이전 논문에서 기술하였듯이[14], Blatter 그룹에서 제시한 열적으로 활성화된 자속-미소거통(thermally activated magnetic flux creep)에 대한 고전이론에 의하면, 전류밀도 /에 대한 붕괴 방정식이 ∂J/∂t ≈ (-J_c/τ₀) exp [- U(J)/kT] 으로 유도됨을 보였다[16]. 여기서 U())는 활성화 에너지이다. 그리 고 1964년에 Anderson-Kim은 열적 활성화에 기인한 피닝-퍼텐셜-우물들(pinning potential wells) 개념을 도입하여 전류 밀도 /와 활성화 에너지 U의 선형적인 관계를 보이고, /= /...[1 - (kT/U_o)ln(1 + t/t_o)] 관계식을 유도하여, 자속-저속거동에 따른 전류밀도 /의 대수적 시간붕괴(logarithmic time decay) 를 설명하였다[15]. 그리고 Bean 임계상태 모델에 의해 /∝ M 이므로[16], 자속-저속거동에 따른 자기자화도 M의 대수적 시 간붕괴(logarithmic time decay)를 예측할 수 있다. 따라서 Anderson-Kim 이론의 대수적 자기완화 관계식을 적용하여 MgB₂ 분말들의 자속-저속거동 현상을 설명할 수 있다. 이를 위해 자속고정효과 등을 규격화된 저속거동비율(normalized creep rate) S를 도입하여 분석하는데, S는 자기완화비율 (magnetic relaxation rate) 혹은 대수적 시간붕괴(logarithmic time decay)율이라고 하며, $S = -(1/M_{irr})[dM_{irr}/d\ln(t)] =$ $-dn(M_{irr})/dn(t) = -dn(f)/dn(t)$ 의 관계식으로 S값을 결정 할 수 있다[15].



Fig. 3. (a) Magnetic moment *m* versus time *t* of diluted water-treated MgB₂ powder for both the increasing field H_{inc} branch and the decreasing field H_{dec} branch, at temperatures of 15, 25, and 35 K with field of H = 1000 G. (b) and (c) show the magnified view of m(t) for both field branches at T = 15 K from (a).

Fig. 1에 나타낸 자기모멘트 m의 자기장 H 의존성인 m(H) 그래프들에 초전도 부피 V_s로 나눠줌으로써 자기자화도 M(H) 그래프들을 얻을 수 있고, 이를 통해 비가역 자기자화도 (irreversible magnetization) M_{irr}(H) 값들을 구할 수 있다. 비 가역 자기자화도 M_{irr}(H) 값은 M_{irr}(H) = |M_{mea} - M_{avg}| 관계 식으로 얻을 수 있으며, 여기서 M_{avg} = [M(H_{dec}) - M(H_{inc})]/2 이고, M(H_{inc})와 M(H_{dec}) 는 M(t) 측정값으로부터 각각 자기장 이 증가하는 영역과 감소하는 영역에서 자기자화도 값들이다.



Fig. 4. Magnetic moment *m* versus time *t* of diluted water-treated MgB₂ powder for both the increasing field H_{inc} branch and the decreasing field H_{dec} branch, at fields from 1000 to 10000 G with temperature of T = 15 K.

이에 따라 본 논문의 두 종류 MgB2 분말들의 자기완화비율 (magnetic relaxation rate) $S = -d\ln(M_{irr})/d\ln(t)$ 을 각각 구하 여 분석하였다. Fig. 5(a)와 5(b)는 순수한 MgB2 분말 시료와 증류수-에탄올 혼합물 처리된 MgB2 분말 시료들에 대하여 지 정된 자기장 세기들(HT = 1000 G ~ 10000 G)에서 자기완화 비율 S의 온도의존성 그래프들을 각각 보여주고 있다. 인위적 인 자속고정점들을 도입하지 않은 두 종류 MgB2 분말 시료들 에 대하여, Fig. 5에서 알 수 있듯이 T = 25 K 이하 온도영역에 서 자기완화비율 S의 작은 값들의 결과들은 고유의 약한 집단 적인 자속고정효과(intrinsic weak collective pinning effect)로 설명할 수 있다. 그리고 MgB2 박막 시료의 결과들과 유사하게 [14] 순수한 MgB₂ 분말 시료의 경우에 T = 10 K 이하 온도영 역과 H_T = 5000 G 이하 자기장에서 자기완화비율 S 값들의 변 화가 거의 없는, 즉 일정한 값들의 결과들은 양자-저속거동-효과(quantum creep effect)의 명확한 현상으로 이해할 수 있 다. 이와 같은 양자-저속거동-효과는 이전 논문들[20-21]에 서 볼 수 있듯이 전류밀도 /(7) 그래프들의 저온 영역에서 완만 한 변화 결과들과 연관하여 설명할 수 있다.

Fig. 6은 본 논문의 순수한 MgB2 분말 시료와 증류수-에탄 올 혼합물 처리된 MgB₂ 분말 시료, 그리고 이전 논문[14]의 MgB2 박막 시료들에 대하여 자기장 HT = 1000 G와 7500 G 세 기에서 자기완화비율 S의 온도의존성 그래프들을 상호 비교하 여 보여주고 있다. Fig. 6에서 알 수 있듯이 순수한 MgB2 분말 시료와 증류수-에탄올 혼합물 처리된 MgB2 분말 시료들의 자 기완화비율 S값들은 서로 거의 차이가 없는 유사한 크기를 가 지며, MgB2 박막 시료의 ab-축으로 인가한 자기장에 의한 자 기완화비율 S 값들과 유사함을 알 수 있다. 그리고 MgB2 박막 시료의 c-축으로 인가한 자기장에 의한 자기완화비율 S값들은 다른 시료들에 비하여 상대적으로 큼을 알 수 있다. 순수한 MgB₂ 분말 혹은 증류수-에탄올 혼합물 처리된 MgB₂ 분말들 은 MgB₂ 다결정(poly-crystal) 물질로서 입계 경계면 사이에 존재하는 자속고정효과(flux pinning effect) 혹은 분말들의 입 계 사이에 존재하는 다양한 결함(defect)들로 인한 자속고정효 과들이 단결정 MgB2 박막 시료에 비하여 강하게 나타남을 예 측할 수 있고, 이는 Fig. 6의 자기완화비율 S의 온도의존성 그래 프 결과들로 잘 설명된다.



Fig. 5. Flux creep rate *S* versus temperature *T* for (a) the pure MgB_2 powder and (b) the diluted water-treated MgB_2 powder, at fields from 1000 to 10000 G.



Fig. 6. Flux creep rate *S* versus temperature *T* for several MgB₂ samples with (a) H = 1000 G and (b) H = 7500 G.

4.결 론

순수한 MgB2 분말 시료와 증류수-에탄올 혼합물 처 리된 MgB2 분말 시료들의 자기완화 특성들을 조사하 였다. T=5~35 K의 지정된 온도와 HT = 1000~10000 G의 지정된 자기장에서 약 7200 s 시간 동안에 약 100 s 간격으로 자기모멘트 m(t)의 시간 의존성을 PPMS-VSM 마그네토미터(magnetometer) 장비를 이용 하여 측정하였다. 순수한 MgB2 분말 시료의 경우에 온 도 T = 5 K와 T = 15 K에서 약 7200 s 동안 자기모멘트 m 값들이 0.5 ~ 1.0% 와 0.7 ~ 1.8% 정도로 각각 감소하 였으며, 증류수-에탄올 혼합물 처리된 MgB2 분말 시료 의 경우에 온도 T = 15 K에서 약 7200 s 동안 자기모멘 트 m 값들이 0.6 ~ 1.0% 정도로 감소하였다. Anderson-Kim 이론에 의한 대수적 자기완화 관계식 S= -*d*ln(*M*_{irr})/*d*ln(*t*)을 이용하여 두 종류 MgB₂ 분말들의 자 기완화 특성을 조사하였다. 자기완화비율 S 값들은 비 가역 자기자화도 시간 의존성 M(t) 결과들을 이용하여 구하였다. 순수한 MgB2 분말 시료와 증류수-에탄올 혼 합물 처리된 MgB2 분말 시료들의 자기완화비율 S 값들 은 거의 비슷하였으나, MgB2 박막 시료의 c-축 자기장 결과들과 비교하면 현저하게 작은 값을 나타내었다. 이 를 통해 다결정(poly-crystalline) MgB2 분말 시료들의 자 속고정효과(flux pinning effect) 특성들이 단결정(single crystalline) MgB2 박막 시료의 c-축 자기장에 의한 특성 들보다 현저하게 우수함을 예측하였다. 한편, MgB2 박 막 시료의 경우와 유사하게 T = 10 K 이하 온도영역에 서 자기완화비율 S 값들은 거의 같은 크기로 일정하였 고, 이는 양자-저속거동-효과(quantum creep effect)의 현 상으로 설명하였다.

ACKNOWLEDGMENT

This work was supported by a grant from the Basic Science Research Program, administered through the National Research Foundation of Korea (NRF) and funded by the Ministry of Education (NRF-2021R1A2C1094771).

REFERENCES

- J. Nagamatsu, N. Nagagawa, T. Muranaka, Y. Zenitani and J. Akimitsu, "Superconductivity at 39 K in magnesium diboride," *Nature*, vol. 401, pp. 63, 2001.
- [2] C. Buzea and T. Yamashita, "Review of superconducting properties of MgB₂," *Supercond. Sci. Technol.*, vol. 14, pp. R115-R150, 2001, and references therein.
- [3] Setsuko Tajima, "The second special issu of Physica C on MgB2," *Physica C*, vol. 456, pp. 1, 2007, and references therein.
- [4] H. J. Choi, D. Roundy, H. Sun, M. L. Cohen and S. G. Louie, "The origin of the anomalous superconducting properties of MgB₂," *Nature*, vol. 418, pp. 758-760, 2002.
- [5] S. Souma, Y. Machida, T. Sato, T. Takahashi, H. Matsui, et al., "The origin of multiple superconducting gaps in MgB₂," *Nature*, vol. 423, pp. 65-67, 2003.
- [6] D. C. Larbalestier, L. D. Cooley, M. O. Rikel, A. A. Polyanskii, J. Y. Jiang, et al., "Strongly linked current flow in polycrystalline forms of the superconductor MgB₂," *Nature*, vol. 410, pp. 186-189, 2001.
- [7] V. G. Kogan and S. L. Bud'ko, "Anisotropy parameters of

superconducting MgB₂," *Physica C*, vol. 385, pp. 131-142, 2003, and references therein.

- [8] S. X. Dou, S. Soltanian, J. Horvat, X. L. Wang, S. H. Zhou, M. Lonescu, H. K. Liu, P. Munroe, and M. Tomsic, "Enhancement of the critical current density and flux pinning of MgB₂ superconductor by nanoparticle SiC doping," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 81, pp. 3419-3421, 2002.
- [9] K. J. Song, S. W. Kim, C. Park, J. K. Chung, J. S. Yang, J. H. Joo, R. K. Ko, H. S. Ha, H. S. Kim, D. W. Ha, S. S. Oh, E. Y. Lee, Y. K. Kwon, and G. H. Rim, "The effect of nano-powder additions on the superconducting properties of MgB₂," *IEEE Trans. Appl. Supercond.*, vol. 15, pp. 3288-3291, 2005.
- [10] A. Gurevich, "Enhancement of the upper critical field by nonmagnetic impurities in dirty two-gap superconductors," *Phys. Rev. B, Condens. Matter*, vol. 67, pp. 184515-1-13, 2003.
- [11] A. Gurevich, S. Patnaik, V. Braccini, K. H. Kim, C. Mielke, X. Song, L. D. Cooley, S. D. Bu, D. M. Kim, J. H. Choi, L. J. Belenky, J. Giencke, M. K. Lee, W. Tian, X. Q. Pan, A. Siri, E. E. Hellstrom, C. B. Eom, and D. C. Larbalestier, "Very high upper critical fields in MgB₂ produced by selective tuning of impurity scattering," *Supercond. Sci. Technol.*, vol. 17, pp. 278-286, 2004.
- [12] Y. Yeshurun, A. P. Malozemoff, and A. Shaulov, "Magnetic relaxation in high-temperature superconductors," *Rev. Mod. Phys.*, vol. 68, no. 3, pp. 911-949, 1996, and references therein.
- [13] H. H. Wen, S. L. Li, Z. W. Zhao, H. Jin, Y. M. Ni, W. N. Kang, H.-J. Kim, E.-M. Choi, and S.-I. Lee, "Magnetic relaxation and critical current density of MgB₂ thin films," *Phys. Rev. B*, vol. 64, pp. 134505-1-5, 2001.

- [14] K. J. Song, W. N. Kang, and C. Park, "The magnetic relaxation of MgB₂ thin films grown by hybrid physical-chemical vapor deposition," *IEEE Trans. Appl. Supercond.*, vol. 26, no. 4, pp. 8200804, 2006.
- [15] P. W. Anderson and Y. B. Kim, "Hard superconductivity: Theory of the motion of Abrikosov flux lines," *Rev. Mod. Phys.*, vol. 36, no. 1, pp. 39-43, 1964.
- [16] G. Blatter, M. V. Feigel'man, V. B. Geshkenbein, A. I. Lakin, and V. M. Vinokur, "Vortices in high temperature superconductors," *Rev. Mod. Phys.*, vol. 66, no. 4, pp. 1125-1388, 1994.
- [17] K. J. Song, R. K. Ko, H. S. Kim, T. H. Kim, N. J. Lee, H. S. Ha, D. W. Ha, S. S. Oh, S. H. Moon, C. Park, and S. I. Yoo, "The effect of solvent treatments and aging on the superconducting properties of MgB₂ materials," *Physica C, Supercond.*, vol. 467, pp. 106-111, 2007.
- [18] K. J. Song, J. C. Lim, S. Kang, R. K. Ko, K. C. Chung, S. Yoon, and C. Park, "The effect of diluted water treatments on the superconducting properties of MgB₂," *IEEE Trans. on Appl. Supercond.*, vol. 23, no. 3, pp. 7100304, 2013.
- [19] C. P. Bean, "Magnetization of high-field superconductors," *Rev. Mod. Phys.*, vol. 36, pp. 31-36, 1964.
- [20] K. J. Song, C. Park, and S. Kang, "The effect of SiC nanoparticle addition on the flux pinning properties of MgB₂," Physica C, vol. 470, pp. 470-474, 2010.
- [21] J. C. Lim, K. J. Song, and W. N. Kang, "Magnetic properties of MgB₂ thin films grown by using HPCVD," *New Phys., Sae Mulle*, vol. 63, no. 11, pp. 1241-1248, 2013.